

A-7 次の記述は、電界効果トランジスタ(FET)について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

- 1 構造が、金属(ゲート) - 酸化膜(絶縁物) - 半導体により形成されているものをMOS形FETという。○
- 2 FETは、接合形とMOS形に大別され、MOS形にはデプレッション形とエンハンスメント形がある。○
- 3 ガリウムヒ素(GaAs)FETは、マイクロ波の発振回路素子や増幅回路素子として用いられている。○
- 4 FETは、一般のバイポーラトランジスタのような電流制御型に対し、電圧制御素子である。○
- 5 MOS形FETを部品単体で保管するときは、内部の酸化膜(絶縁物)が静電気で破壊されないように、一般的にゲートとソースを開放状態にしておくといふ。X

